

Description

Semicoa Semiconductors offers:

- Screening and processing per MIL-PRF-19500 Appendix E
- JAN level (2N3485AJ)
- JANTX level (2N3485AJX)
- JANTXV level (2N3485AJV)
- QCI to the applicable level
- 100% die visual inspection per MIL-STD-750 method 2072 for JANTXV
- Radiation testing (total dose) upon request

Please contact Semicoa for special configurations
www.**SEMICOA**.com or (714) 979-1900

Applications

- General purpose switching
- Low power
- PNP silicon transistor



Features

- Hermetically sealed TO-46 metal can
- Also available in chip configuration
- Chip geometry 0600
- Reference document:
MIL-PRF-19500/392

Benefits

- Qualification Levels: JAN, JANTX, and JANTXV
- Radiation testing available

Absolute Maximum Ratings		$T_C = 25^\circ\text{C}$ unless otherwise specified	
Parameter	Symbol	Rating	Unit
Collector-Emitter Voltage	V_{CEO}	60	Volts
Collector-Base Voltage	V_{CBO}	60	Volts
Emitter-Base Voltage	V_{EBO}	5	Volts
Collector Current, Continuous	I_C	600	mA
Power Dissipation, $T_A = 25^\circ\text{C}$ Derate linearly above 37.5°C	P_T	0.5 3.08	mW mW/ $^\circ\text{C}$
Power Dissipation, $T_C = 25^\circ\text{C}$ Derate linearly above 25°C	P_T	2.0 11.43	mW mW/ $^\circ\text{C}$
Thermal Resistance	$R_{\theta JA}$ $R_{\theta JC}$	0.325 87	$^\circ\text{C}/\text{W}$
Operating Junction Temperature Storage Temperature	T_J T_{STG}	-65 to +200	$^\circ\text{C}$

ELECTRICAL CHARACTERISTICS

characteristics specified at $T_A = 25^\circ\text{C}$

Off Characteristics

Parameter	Symbol	Test Conditions	Min	Typ	Max	Units
Collector-Emitter Breakdown Voltage	$V_{(BR)CEO}$	$I_C = 10\text{ mA}$	60			Volts
Collector-Base Cutoff Current	I_{CBO1}	$V_{CB} = 60\text{ Volts}$			10	μA
	I_{CBO2}	$V_{CB} = 50\text{ Volts}$			10	nA
	I_{CBO3}	$V_{CB} = 50\text{ Volts}, T_A = 150^\circ\text{C}$			10	μA
Emitter-Base Cutoff Current	I_{EBO1}	$V_{EB} = 5\text{ Volts}$			10	μA
	I_{EBO2}	$V_{EB} = 3.5\text{ Volts}$			50	nA

On Characteristics

Pulse Test: Pulse Width = 300 μs , Duty Cycle $\leq 2.0\%$

Parameter	Symbol	Test Conditions	Min	Typ	Max	Units
DC Current Gain	h_{FE1}	$I_C = 0.1\text{ mA}, V_{CE} = 10\text{ Volts}$	40			
	h_{FE2}	$I_C = 1.0\text{ mA}, V_{CE} = 10\text{ Volts}$	40			
	h_{FE3}	$I_C = 10\text{ mA}, V_{CE} = 10\text{ Volts}$	40			
	h_{FE4}	$I_C = 150\text{ mA}, V_{CE} = 10\text{ Volts}$	40		120	
	h_{FE5}	$I_C = 500\text{ mA}, V_{CE} = 10\text{ Volts}$	40			
	h_{FE6}	$I_C = 1.0\text{ mA}, V_{CE} = 10\text{ Volts}$ $T_A = -55^\circ\text{C}$	20			
Base-Emitter Saturation Voltage	V_{BEsat1}	$I_C = 150\text{ mA}, I_B = 15\text{ mA}$			1.3	Volts
	V_{BEsat2}	$I_C = 500\text{ mA}, I_B = 50\text{ mA}$			2.6	
Collector-Emitter Saturation Voltage	V_{CEsat1}	$I_C = 150\text{ mA}, I_B = 15\text{ mA}$			0.4	Volts
	V_{CEsat2}	$I_C = 500\text{ mA}, I_B = 50\text{ mA}$			1.6	

Dynamic Characteristics

Parameter	Symbol	Test Conditions	Min	Typ	Max	Units
Magnitude – Common Emitter, Short Circuit Forward Current Transfer Ratio	$ h_{FE} $	$V_{CE} = 20\text{ Volts}, I_C = 50\text{ mA}, f = 100\text{ MHz}$	2.0		10	
Small Signal Short Circuit Forward Current Transfer Ratio	h_{FE}	$V_{CE} = 10\text{ Volts}, I_C = 1\text{ mA}, f = 1\text{ kHz}$	40			
Open Circuit Output Capacitance	C_{OBO}	$V_{CB} = 10\text{ Volts}, I_E = 0\text{ mA}, 100\text{ kHz} < f < 1\text{ MHz}$			8	pF
Open Circuit Input Capacitance	C_{IBO}	$V_{EB} = 2\text{ Volts}, I_C = 0\text{ mA}, 100\text{ kHz} < f < 1\text{ MHz}$			30	pF

Switching Characteristics

Saturated Turn-On Time	t_{ON}				45	ns
Saturated Turn-Off Time	t_{OFF}				175	ns

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9